

# 第三届宽禁带半导体学术会议在西安胜利召开-电子与信息学部



发布时间：2019-10-21 点击量：241

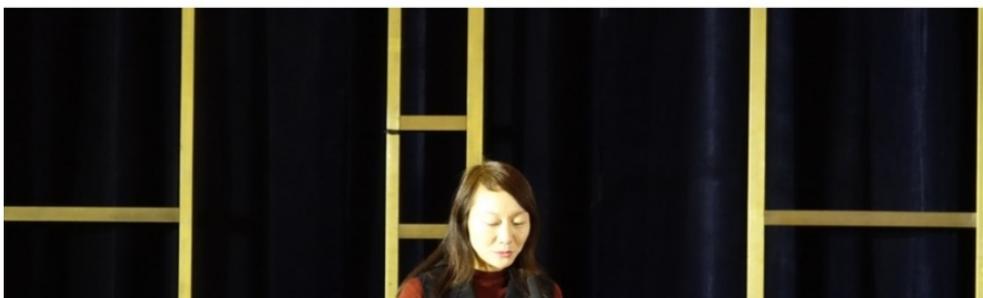
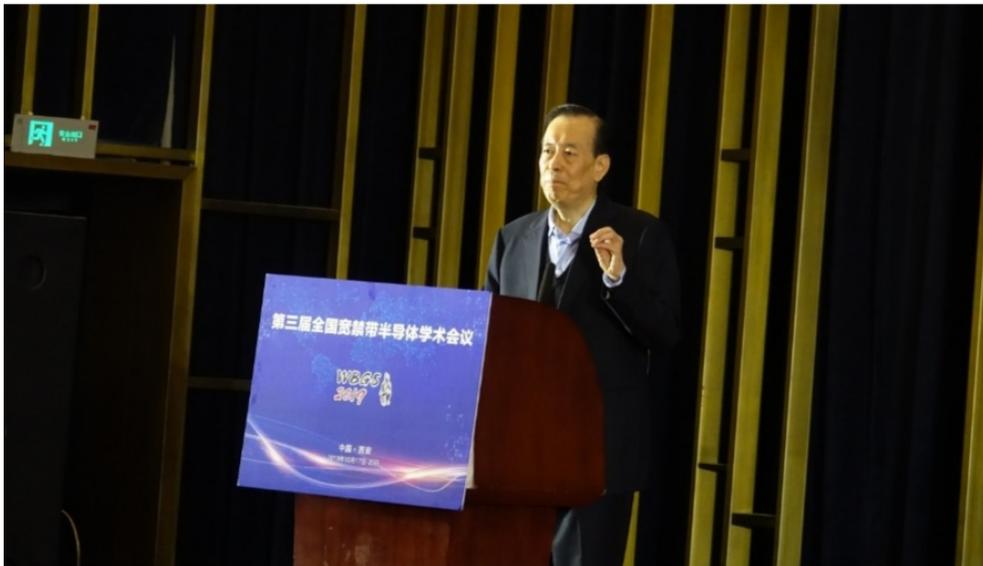


金秋十月，秋风送爽，第三届宽禁带半导体学术会议于10月17-20日在十三朝古都西安隆重召开。本次会议由中国电子学会电子材料分会、中国有色金属学会宽禁带半导体专业委员会共同主办，西安交通大学等单位承办。



在由西安交通大学电子物理与器件教育部重点实验室主任、宽禁带半导体材料与器件研究中心主任王宏兴执行主席主持的开幕式上，大会主席西安交通大学侯洵院士致开幕辞，大会副主席国家自然科学基金委信息部主任郝跃院士、西安市科学技术局党组书记、局长李志军、西安交通大学电信学部书记梁莉、中国电子学会电子材料学分会主任委员、中国科学院苏州纳米所所长杨辉分别致辞，对大会的召开表示热烈的祝贺。西安电子科技大学郝跃院士、厦门大学张荣校长、南昌大学江风益副校长、中国科学院半导体研究所李晋闽所长、北京大学沈波教授、香港科技大学刘纪美教授、中国科学院北京纳米能源与系统研究所王中林院士、西安交通大学王宏兴教授、山东大学陶绪堂教授、浙江大学叶志镇教授、台湾交通大学郭浩中教授、中国科学院苏州纳米技术与纳米仿生研究所徐科教授、中国电科第十三研究所副所长蔡树军研究院应大会邀请分别就宽禁带半导体器件与5G通信、宽禁带半导体紫外探测技术及产业化、氮化物半导体大失配异质外延与单晶生长及应用、GaN功率器

件、金刚石晶体生长及电子器件、氧化镓晶体生长与器件研究、氧化锌光电薄膜研究及应用、第三代半导体的压电电子学与压电光电子学等方面做了大会主旨报告。





10月18日下午和19日上午大会展开了各分会的学术交流与讨论，分会场围绕材料制备和测试分析设备、材料生长和物性分析、发光器件、探测与成像器件、功率电子与射频电子器件、以金刚石为代表的新型宽禁带半导体材料与器件六个主题进行。每个分会场都汇集了相关领域的专家和学者，同时，也吸引了很多相关专业的学生代表和企业代表。在每个报告结束时的提问环节，代表们都踊跃提问，积极参与，进行了热烈的讨论和交流。



10月18日晚间，组委会针对当前宽禁带领域的热点问题在Micro-LED面临的关键科学技术问题和产业化前景、SiC、GaN、Ga<sub>2</sub>O<sub>3</sub>在功率电子器件领域的细分市场和产业化前景两个方面展开了深度互动和专题研讨。在程序委员会主席北京大学沈波教授的主持下，来自香港科技大学的刘纪美教授、南京大学的刘斌教授、中国科学院半导体研究所的李晋闽所长、中国科学院苏州纳米技术与纳米仿生研究所的孙钱教授、南方科技大学的刘召军教授、西安电子科技大学的宋庆文教授、中国电科第十三研究所的冯志红研究员、中国科学院苏州纳米技术与纳米仿生研究所的徐科研究员、中国科学院微电子研究所的黄森研究员、中国电科第四十六研究所的刘峰研究员、西安交通大学的王来利教授作为讨论嘉宾围绕两个专利分别阐述了自己的看法。讨论嘉宾与参会代表展开了深入而热烈的探讨和互动，并对未来的发展提出了诚恳的建议。



此次会议为第三代宽禁带半导体材料和器件等相关领域的专家、学者、技术人员及企业家等提供学术交流平台，加强国内外同行业之间的相互了解和合作，共同促进第三代宽禁带半导体材料及其电子器件行业及相关产业的蓬勃发展。

本次会议收到全国界的广泛关注，大会共计收到学术交流论文300余篇，大会包含14篇大会主旨报告、61篇分会邀请报告、96篇分会口头报告、130余篇张贴海报报告。总共有来自40多所国内著名高校、科研院所以及业界的专家学者、工程师430余人参会，其中学生140余人。通过与国内各相关领域专家学者的交流，借此了解宽禁带半导体及其器件研究领域的最新进展，为发展新的实验方法、理论并凝炼关键科学问题提供依据，全面推动以宽禁带半导体材料为基础的跨学科、跨领域的深入实质性的合作，促进我国宽禁带半导体材料及其器件研究平台的建设，并通过共同努力，拓展该类先进材料与器件的应用与成果转化。

在闭幕式上，中国电子学会电子材料学分会杨辉主任委员作为主办方代表为本届大会做了简要总结。他表示，本届宽禁带半导体学术会议参与人数多，会议设置紧凑，大会特邀报告和各分会专题报告都精彩纷呈，且含金量十足；在学术上的前沿探讨和思路引领，为研究人员带来了新技术、新领域、新思路和新方向，很大程度上为我国战略性先进电子材料发展提供良好的支撑；希望各参会代表能抓住良好机会，严谨治学，认真学习，专心研究，把专业研究成果转化为工业应用，为实现科技强国伟大目标贡献力量。同时，杨辉所长、张国义副主席、李晋闽所长、徐科教授、王宏兴执行主席为经过程序委员会严格评选的十位优秀论文获得者颁发获奖证书。

